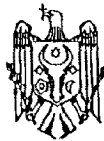




MD 4882 C1 2024.08.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) **4882** (13) **C1**
(51) Int.Cl: *C01G 9/00* (2006.01)
C01G 15/00 (2006.01)
C04B 35/00 (2006.01)
C04B 35/453 (2006.01)
C04B 35/65 (2006.01)
C30B 13/18 (2006.01)

(12) BREVET DE INVENȚIE

<p>(21) Nr. depozit: a 2020 0024 (22) Data depozit: 2020.03.27</p> <p>(41) Data publicării cererii: 2021.09.30, BOPI nr. 9/2021</p>	<p>(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2024.01.31, BOPI nr. 1/2024</p>
<p>(71) Solicitant: INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD (72) Inventatori: COLIBABA Gleb, MD; RUSNAC Dumitru, MD; FEDOROV Vladimir, MD (73) Titular: INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD</p>	

(54) Procedee de obținere a țintelor ceramice și a straturilor subțiri de
ZnO:Ga:Cl la temperaturi scăzute

(57) Rezumat:

1
Invenția se referă la procedeele de obținere a materialelor semiconductoare și poate fi utilizată în tehnologia semiconductoarelor.

Procedeele de obținere a țintelor ceramice de ZnO:Ga:Cl la temperaturi scăzute constă în sinterizarea pulberilor de ZnO și Ga₂O₃ într-un volum închis la temperatura de 900...1150°C. Sinterizarea se efectuează prin reacții chimice de transport, utilizând HCl în calitate de agent de transport, cu presiunea inițială de 0,101...0,608 MPa, totodată suplimentar se utilizează pulveri de Ga₂O₃ cu concentrația de 1...5 mol% și mărimea granulelor nu mai mare de 300 μm pentru

2
obținerea țintelor ceramice de ZnO:Ga:Cl, impuritățile de Cl având concentrația de $1 \cdot 10^{18} \dots 5 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$.

Procedeele de obținere a straturilor subțiri de ceramică de ZnO:Ga:Cl la temperaturi scăzute constă în vacuumarea camerei magnetronului până la presiunea de $133,32 \div 666,61 \cdot 10^{-5} \text{ Pa}$, injectarea gazului Ar cu presiunea de $0,00013 \div 0,0013 \text{ MPa}$, pulverizarea cu magnetron la temperatura de depunere de 80...300°C a țintelor ceramice de ZnO:Ga:Cl obținute prin procedeul descris mai sus.

Revendicări: 2
Figuri: 5

MD 4882 C1 2024.08.31

(54) Methods for producing ZnO:Ga:Cl ceramic targets and thin films at low temperatures

(57) Abstract:

1
The invention relates to semiconductor material production methods and can be used in semiconductor technology.

The method for producing ZnO:Ga:Cl ceramic targets at low temperatures consists in sintering ZnO and Ga₂O₃ powders in a closed volume at a temperature of 900...1150°C. Sintering is carried out by chemical transport reactions, using HCl as a transport agent, with an initial pressure of 0.101...0.608 MPa, at the same time Ga₂O₃ powders are additionally used with a concentration of 1...5 mol% and a granule size of no more than 300 μm to produce ZnO:Ga:Cl ceramic targets, Cl

2
impurities having a concentration of $1 \cdot 10^{18} \dots 5 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$.

The method for producing ZnO:Ga:Cl thin layers at low temperatures consists in vacuumization of magnetron chamber to a pressure of $133.32 \div 666.61 \cdot 10^{-5} \text{ Pa}$, Ar gas injection with a pressure of $0.00013 \div 0.0013 \text{ MPa}$, magnetron sputtering at a deposition temperature of 80...300°C of ZnO:Ga:Cl ceramic targets produced by the method described above.

Claims: 2

Fig.: 5

(54) Способы получения керамических мишеней и тонких пленок ZnO:Ga:Cl при низких температурах

(57) Реферат:

1
Изобретение относится к способам получения полупроводниковых материалов и может быть использовано в полупроводниковой технологии.

Способ получения керамических мишеней ZnO:Ga:Cl при низких температурах состоит в спекании порошков ZnO и Ga₂O₃ в закрытом объеме при температуре 900...1150°C. Спекание осуществляется химическими транспортными реакциями, используя HCl в качестве транспортного агента, с начальным давлением 0,101...0,608 МПа, при этом дополнительно используют порошки Ga₂O₃ с концентрацией 1...5 моль%, с размером гранул не более 300 мкм

2
для получения керамических мишеней ZnO:Ga:Cl, примеси Cl имея концентрацию $1 \cdot 10^{18} \dots 5 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$.

Способ получения керамических тонких слоев ZnO:Ga:Cl при низких температурах состоит в вакуумировании камеры магнетрона до давления $133,32 \div 666,61 \cdot 10^{-5} \text{ Па}$, нагнетании газа Ar с давлением $0,00013 \div 0,0013 \text{ МПа}$, магнетронном напылении при температуре осаждения 80...300°C керамических мишеней ZnO:Ga:Cl, полученных выше описанным способом.

П. формулы: 2

Фиг.: 5

Descriere:

Invenția se referă la procedeele de obținere a materialelor semiconductoare și poate fi utilizată în tehnologia semiconductoarelor.

5 Straturile subțiri de oxid de zinc (ZnO) cu uniformitate înaltă și rezistivitate redusă posedă un potențial aplicativ divers, inclusiv la dispozitive fotovoltaice și emițătoare de lumină. Un procedeu relativ simplu și ieftin de obținere a straturilor de ZnO constă în pulverizarea magnetron a țintelor ceramice de ZnO, dopate cu impurități de Al, Ga sau In cu concentrație și uniformitate înaltă de dopare pe tot volumul țintei [1].

10 Impuritatea de Ga are o solubilitate ridicată în ceramică și straturi de ZnO, prin urmare, ceramica ZnO:Ga este adesea folosită pentru a obține straturi cu cea mai mică rezistivitate. Prepararea țintelor ceramice reprezintă cea mai costisitoare parte din obținerea straturilor subțiri de ZnO și a diferitor utilaje electronice în baza acestor straturi.

15 Este cunoscut, de asemenea, procedeul de obținere a țintelor ceramice de ZnO dopate prin tratarea termică a amestecurilor de pulbere de ZnO și a combinației de oxizi din urma procesului de presare a pulberilor de ZnO la presiunea de 49 MPa și sintetizarea ulterioară în atmosferă la temperatura de 200...1400°C [2].

Dezavantajele acestui procedeu constau în:

20 (i) necesitatea utilizării tehnologiei de presare înaltă a pulberii inițiale (presiunea recomandată este de 5,88–49,03 MPa);

(ii) efectul micșorării dimensiunilor (diametrului) ceramicii în procesul de tratare termică, atingând ~ 18%;

(iii) dificultăți tehnologice de sinterizare repetată a țintei deja utilizate, parțial evaporate;

25 (iv) necesitatea tratării termice la temperaturi înalte de 1100-1400°C, pentru a obține o duritate și densitate destul de înalte a țintelor, totodată micșorând rezistivitatea acestora.

De asemenea, este cunoscut procedeul de obținere a straturilor subțiri de ceramică de ZnO:Ga prin metoda pulverizării magnetron în rezultatul utilizării ceramicii de ZnO dopate cu Ga₂O₃, unde au fost obținute straturi cu rezistivitate nu mai mare de $3,8 \cdot 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$, la grosimea straturilor de 300 nm, cu condiția ca temperatura substratului să dețină temperatura de la 50 până la 300°C, în special la temperatura substratului de 250°C după care această temperatură va crește neesențial [3].

30 Neajunsul folosirii unor astfel de ținte constă în aceea că la temperaturi mai joase de depunere, de exemplu la 100°C, impuritatea de Ga se introduce în rețeaua cristalină de ZnO ca defect electric inactiv, iar în consecință, crește rezistivitatea straturilor subțiri de ZnO:Ga până la $1,2 \cdot 10^{-3} \Omega \cdot \text{cm}$. În același timp, tendințele actuale cer micșorarea temperaturii de creștere a straturilor subțiri până la 35 100°C, ceea ce permite să se obțină structuri în componența cărora să fie straturile subțiri de ZnO cu alte materiale slab rezistente la temperatură, precum materialele organice.

Problema pe care o rezolvă invenția constă în elaborarea tehnologiei de sinterizare a țintelor ceramice de ZnO:Ga:Cl la temperatura scăzută de $\leq 1150^\circ\text{C}$, care ar asigura obținerea ceramicii cu parametri necesari cu rezistivitatea de $\leq 10^2 \Omega \cdot \text{cm}$, duritatea de $\geq 1 \text{ GPa}$ și densitatea de $\geq 4 \text{ g/cm}^3$, pentru pulverizarea cu magnetron, fără de a micșora diametrul și fără de a utiliza presarea pulberii inițiale, cu posibilitatea de sinterizare repetată a ceramicii prin creșterea volumului acesteia, și care nu ar necesita folosirea pulberilor scumpe de Ga₂O₃. Astfel de ținte ceramice permit obținerea straturilor subțiri de ZnO la temperaturi scăzute, cu o rezistivitate mai mică.

45 Procedeul de obținere a țintelor ceramice de ZnO:Ga:Cl la temperaturi scăzute, înlătură dezavantajul menționat mai sus prin aceea că constă în sinterizarea pulberilor de ZnO și Ga₂O₃ într-un volum închis la temperatura de 900...1150°C sinterizarea se efectuează prin reacții chimice de transport, utilizând HCl în calitate de agent de transport, cu presiunea inițială de 0,101...0,608 MPa, totodată se utilizează pulberi de Ga₂O₃ cu concentrația de 1...5 mol% cu mărirea granulelor nu mai mare de 300 μm pentru obținerea țintelor ceramice de ZnO:Ga:Cl, impuritățile de Cl având concentrația de $1 \cdot 10^{18} \dots 5 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$.

50 Procedeul de obținere a straturilor subțiri de ZnO:Ga:Cl la temperaturi scăzute, înlătură dezavantajul menționat mai sus prin aceea că constă în vacuumarea camerei magnetronului până la presiunea de $133,32 \div 666,61 \cdot 10^{-5} \text{ Pa}$, injectarea gazului Argon (Ar) cu presiunea de $0,00013 \div 0,0013 \text{ MPa}$, pulverizarea magnetron la temperatura de depunere de 80...300°C a țintelor ceramice de 55 ZnO:Ga:Cl, obținute prin procedeul descris mai sus.

Rezultatul tehnic al invenției constă în aceea că:

(i) parametrii țintelor ceramice de ZnO:Ga:Cl cu diametrul de $99\pm 1\%$ din diametrul pulberii inițiale, cu duritatea înaltă de $2,0\pm 0,2$ GPa, cu densitatea înaltă de $5,3\pm 0,2$ g/cm³, dispune de rezistivitate scăzută = $(1,4\pm 0,1)\cdot 10^{-3}$ Ω·cm și dopare uniformă cu Ga₂O₃ până la concentrația de 5 mol%;

(ii) parametrii straturilor subțiri de ZnO:Ga:Cl depuse la temperatura de 80-300°C cu rezistivitatea de $(4,5\pm 0,5)\cdot 10^{-3}$ Ω·cm și transparență optică în diapazonul vizibil al spectrului de 80-90 % la grosimea straturilor de 300 μm.

Invenția prezintă următoarele avantaje:

Pentru ținta ceramică:

(i) diametrul țintelor ceramice este condiționat de diametrul camerei de sinterizare folosite. Schimbarea diametrului nu se produce din cauza reacțiilor chimice de transport a materialului de ZnO+Ga₂O₃ pe fundul camerei de sinterizare cu o temperatură mai scăzută;

(ii) duritatea și densitatea înalte ale țintelor ceramice sunt similare cu valorile corespunzătoare ale monocristalelor de ZnO. Aceasta se datorează utilizării a HCl, asigurând eficiența reacției de transport chimic la temperatura de 900÷1150°C;

(iii) rezistivitatea scăzută a țintelor ceramice condiționată de impuritatea donora de Ga. Dizolvarea omogenă a Ga₂O₃ se atinge în condiția în care concentrația de Ga₂O₃ nu depășește 5 mol%, iar dimensiunea granulelor de Ga₂O₃ să fie nu mai mult de 300 μm. La concentrații mai mari sau la dimensiuni mai mari ale granulelor de Ga₂O₃ are loc o dizolvare incompletă a adausurilor de dopaj. Posibilitatea dizolvării Ga₂O₃ la temperaturi scăzute de 900÷1150°C, în comparație cu metodele clasice de sinterizare la temperaturi de 1100÷1400°C, este condiționată de reacțiile chimice de transport pe bază de HCl; dizolvarea Ga₂O₃ nu se realizează prin procese lente de difuzie a Ga₂O₃, ci prin difuzarea rapidă a produselor gazoase din reacțiile chimice de transport, de exemplu prin vaporii de GaCl₃. Micșorarea temperaturii de sinterizare ușurează și evită cheltuielile mari la producerea țintelor ceramice de ZnO:Ga:Cl;

(iv) sinterizarea cu ajutorul reacțiilor chimice de transport pe bază de HCl nu necesită presarea pulberii inițiale sau a unei ținte ceramice parțial evaporate. Este posibilă sinterizarea repetată a țintelor ceramice cu adăugarea de material nou.

Pentru straturi subțiri:

(i) rezistivitatea scăzută a straturilor subțiri de ZnO obținute prin metoda pulverizării magnetron a țintelor ceramice este de $4,5\cdot 10^{-4}$ Ω·cm, la grosimea straturilor de ~300 μm și la temperatura de depunere de 80-300°C. Aceasta este condiționată de prezența impurităților de Cl în ținte, cu concentrația de $1\cdot 10^{18}\dots 5\cdot 10^{19}$ cm³, și Ga₂O₃ cu concentrația de 1÷5 mol%. La concentrații de Ga₂O₃ mai mici, rezistivitatea straturilor de ZnO e cu mult mai mare. Impuritatea secundară de Cl ajută la introducerea impurității pe bază de Ga în rețeaua cristalină de ZnO la temperaturi destul de scăzute. Acest efect reduce concentrația defectelor electrice inactive de impurități pe bază de Ga în lipsa impurității de Cl în ținta ceramică, rezistivitatea straturilor de ZnO constituie $1,2\cdot 10^3$ Ω·cm (temperatura de depunere de 100°C, grosimea de 300 μm).

Invenția se explică prin desenele din fig. 1–5, care reprezintă:

- fig. 1, schema cuptorului electric utilizat, profilul axial de temperatură a acestuia, și schema camerei de sinterizare, unde: 1 – tubul de ceramică a cuptorului, 2 – bobina electrică de încălzire, 3 – izolatorul termic, 4 – profilul axial de temperatură a cuptorului, 5 – termocuplu de control, 6 – fiola din cuarț, 7 – pulberea de Zn+Ga₂O₃, 8 – placa superioară de cuarț;

- fig. 2, dependența rezistivității ținte ceramice de ZnO:Ga:Cl cu concentrația de Ga₂O₃;

- fig. 3, aspectul exterior al ținte ceramice de ZnO:Ga:Cl, sinterizate cu HCl (0,20265 MPa) în calitate de agent transportator la temperatura de 1050°C;

- fig. 4, schema camerei pentru pulverizarea magnetron, unde: 9 – magnet, 10 – camera de sinterizare din cuarț, 11 – racord pentru gazul de lucru, 12 – catod, 13 – anod, 14 – țintă ceramică, 15 – material pulverizant, 16 – măsuraș cu suporturi, 17 – încălzitor de suporturi;

- fig. 5 a, reprezentarea schematică a spectrului de absorbție a stratului subțire de ZnO:Ga:Cl de la temperatura de 100°C, cu concentrația de Ga₂O₃ în ținte de 3 mol%;

- fig. 5 b, reprezentarea schematică a spectrului de difracție cu raze XRD a stratului subțire de ZnO:Ga:Cl de la temperatura de 100°C, cu concentrația de Ga₂O₃ în ținte de 3 mol%;

Procedeele date cuprind următoarele etape tehnologice.

Pentru obținerea țintelor ceramice: are loc confecționarea camerei de sinterizare din cuarț 10 (fig. 4) cu încărcarea pulberii de ZnO+Ga₂O₃ pe fundul plat al camerei de sinterizare din cuarț 10; vacuumarea prealabilă a camerei de sinterizare din cuarț 10 și încărcarea transportatorului chimic;

instalarea camerei de sinterizare în cuptorul electric (fig. 1) la temperatura camerei; instalarea în cuptor a termocuplului de control 5, de exemplu de tip platină sau platină-rodii; încălzirea cuptorului electric până la temperatura necesară; tratarea termică a camerei de sinterizare din cuarț 10 la temperatura de 900÷1150°C și durata de 48÷72 de ore; răcirea cuptorului electric până la temperatura camerei cu viteza de 100°C/h; extragerea camerei de sinterizare din cuarț 10 din cuptorul electric.

Pentru obținerea straturilor subțiri: rezistivitatea scăzută a straturilor de ZnO se obțin prin metoda pulverizării magnetron a țintelor ceramice, cu o rezistivitate de până la $3,9 \cdot 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$, obținută la temperatura de 100°C și $2,2 \cdot 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$, obținută la temperatura de 250°C, care este condiționată de prezența impurităților de Cl în ținte, cu concentrația de $1 \cdot 10^{18} \dots 5 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$, și Ga₂O₃, cu concentrația de 1÷5 mol%. La concentrații mai mici de Ga₂O₃, rezistivitatea straturilor de ZnO e cu mult mai mare. Impuritatea secundară de Cl ajută infiltrarea impurităților de Ga, care sunt de bază în rețeaua cristalină de ZnO la temperaturi scăzute. În lipsa impurităților de Cl în ținta ceramică, rezistivitatea straturilor de ZnO constituie $1,2 \cdot 10^{-3} \Omega \cdot \text{cm}$, obținută la temperatura de depunere de 100°C și de $3,8 \cdot 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$, obținută la temperatura de depunere de 260 °C.

Exemplu de realizare a invenției.

Procedeul de obținere a țintelor ceramice de ZnO:Ga:Cl la temperaturi scăzute, constă în aceea că pe tubul din ceramică 1 cu diametrul de 5 cm și lungimea de 60 cm (fig. 1), se bobinează o bobină electrică de încălzire 2 cu densitatea bobinării ce oferă obținerea rezistenței de 0,5 Ω/cm, protejată cu un izolator termic 3 pentru obținerea unui profil axial de temperatură a cuptorului 4 de formă parabolică, controlată cu termocuplul de control 5. Fiola din cuarț 6 are un diametru interior de 2,5 cm. În camera de sinterizare, pulberea de ZnO+Ga₂O₃ 7 este încărcată între fundul plat al fiolei din cuarț 6 și placa superioară de cuarț 8. Fiola din cuarț 6 este vacuumată, agentul de transport este încărcat în ea, fiola este sigilată și introdusă în cuptor. Camera de sinterizare din cuarț 10 se instalează în cuptor astfel, încât temperatura vârfului de sinterizare a fiolei ($T_{\text{sinterizare}}$) este cea mai scăzută temperatură. Se efectuează sinterizarea timp de 48 de ore la temperatura medie de 1050°C, în rezultatul căreia se petrece procesul de sinterizare a pulberii de ZnO+Ga₂O₃ la fundul camerei.

Când se utilizează HCl cu presiunea inițială la temperatura de sinteză egală cu 0,20265 MPa și pulbere de ZnO și Ga₂O₃ cu concentrația de 3 mol% se obține ținta ceramică (fig. 2) cu duritatea înaltă de 2±0,2 GPa, densitatea înaltă de 5,5±0,1 g/cm³ și rezistivitatea redusă de $(1,4 \pm 0,1) \cdot 10^3 \Omega \cdot \text{cm}$. Rezistivitatea redusă se datorează dizolvării impurităților de Ga (fig. 3) și de Cl în aceste ținte ceramice.

Procedeul de obținere a straturilor subțiri de ZnO:Ga:Cl la temperaturi scăzute, constă în aceea că în camera de sinterizare din cuarț 10 pentru pulverizarea magnetron (fig. 4), dotată cu magneți 9, se încarcă o țintă ceramică de ZnO:Ga:Cl 14, obținută prin procedeul de obținere a țintelor ceramice de ZnO:Ga:Cl descris mai sus, se încarcă măsura cu suporturi 16 de sticlă pentru straturile subțiri de ZnO. Camera 10 pentru pulverizarea magnetron se vacumează până la o presiune de $39,99672 \cdot 10^{-5} \text{ Pa}$, suporturile se încălzesc până la temperatura de 100°C cu ajutorul încălzitorului de suporturi 17. Prin racordul pentru gazul de lucru 11 se injectează gazul de lucru Ar cu o presiune de $13,332 \cdot 10^{-3} \text{ Pa}$. La catodul 12 și anodul 13 se aplică o diferență de potențial de 400 V. Se pulverizează cu material pulverizant 15 magnetronul ZnO plasat pe suporturi.

Rezistivitatea straturilor subțiri de ZnO:Ga:Cl, care pot fi obținute prin pulverizarea magnetron a unei astfel de ținte la temperatura de 100°C și grosimea de 300 μm, are valoarea de $(4,5 \pm 0,5) \cdot 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$. Straturile subțiri obținute se caracterizează prin transparență optică înaltă în diapazonul vizibil al spectrului de 80-90% (fig. 5 a) și a perfecțiunii structurale ridicate în spectrele XRD (vârf intens 002) (fig. 5 b), ceea ce oferă posibilitatea de a fi folosite în optoelectronică. În cazul în care ținta ceramică de ZnO:Ga nu conține impuritate de Cl, impuritatea pe bază de Ga nu se introduce eficient în rețeaua cristalină a straturilor subțiri de ZnO, crescute la temperaturi relativ joase. Rezistivitatea unor astfel de straturi subțiri de ZnO:Ga la temperatura de depunere de 100°C și grosimea de 300 μm, este de $1,2 \cdot 10^{-3} \Omega \cdot \text{cm}$.

(56) Referințe bibliografice citate în descriere:

1. Jia Liua, Weijia Zhangan, Dengyuan Songb, Qiang Maa, Lei Zhangb, Hui Zhange, Xiaobo Maa, Haiyang Songa, Comparative study of the sintering process and thin film sputtering of AZO, GZO and AGZO ceramics targets, *Ceramics International*, 2014, Vol. 40, p 12905 - 12915
2. Абдуев А.Х., Асваров А.Ш., Ахмедов А.К., Зобов М.Е., Крамынин С.П., Изменение структуры и стехиометрии керамики оксида цинка в процессе спекания в открытой атмосфере, *Мисьма в ЖТФ*, 2015, Vol. 41, p. 42 - 49
3. Абдуев А.Х., Ахмедов А.К., Асваров А.Ш., А.А. Абдулаев, Сульянов С.Н., Влияние температуры роста на свойства прозрачных проводящих пленок ZnO, легированных галием, *Физика и техника полупроводников*, 2010, Vol. 44, p. 34 - 38

(57) Revendicări:

1. Procedeu de obținere a țintelor ceramice de ZnO:Ga:Cl la temperaturi scăzute, care constă în sinterizarea pulberilor de ZnO și Ga₂O₃ într-un volum închis la temperatura de 900...1150°C, sinterizarea se efectuează prin reacții chimice de transport, utilizând HCl în calitate de agent de transport, cu presiunea inițială de 0,101...0,608 MPa, totodată se utilizează pulberi de Ga₂O₃ cu concentrația de 1...5 mol% cu mărimea granulelor nu mai mare de 300 μm pentru obținerea țintelor ceramice de ZnO:Ga:Cl, impuritățile de Cl având concentrația de $1 \cdot 10^{18} \dots 5 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$.

2. Procedeu de obținere a straturilor subțiri de ZnO:Ga:Cl la temperaturi scăzute, care constă în vacuumarea camerei magnetronului până la presiunea de $133,32 \div 666,61 \cdot 10^{-5} \text{ Pa}$, injectarea gazului Ar cu presiunea de 0,00013 ÷ 0,0013 MPa, pulverizarea magnetron la temperatura de depunere de 80...300°C a țintelor ceramice de ZnO:Ga:Cl, obținute prin procedeul din rev. 1.

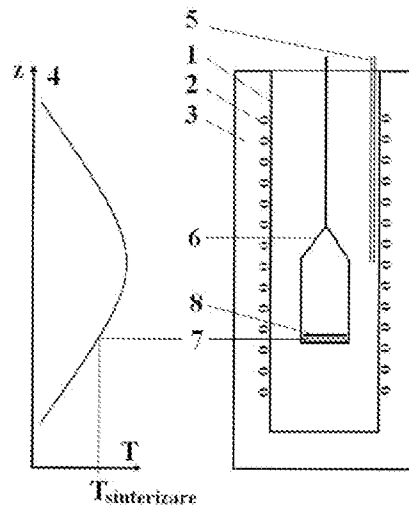


Fig. 1

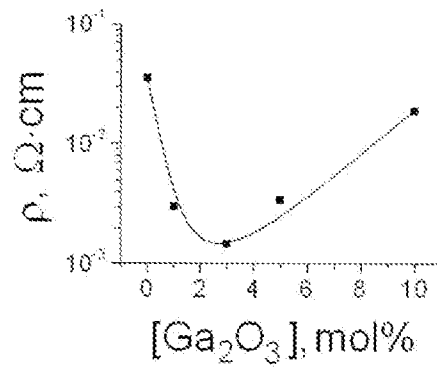


Fig. 2

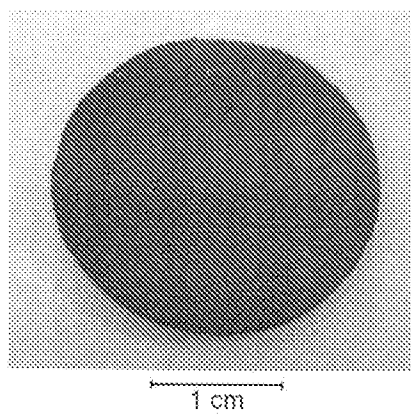


Fig. 3

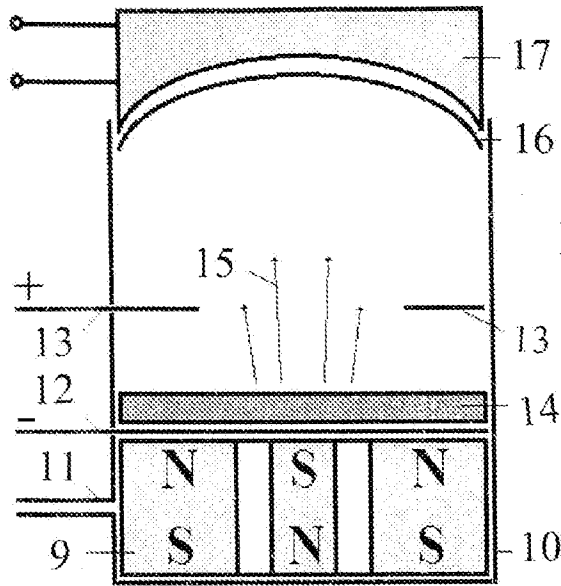


Fig. 4

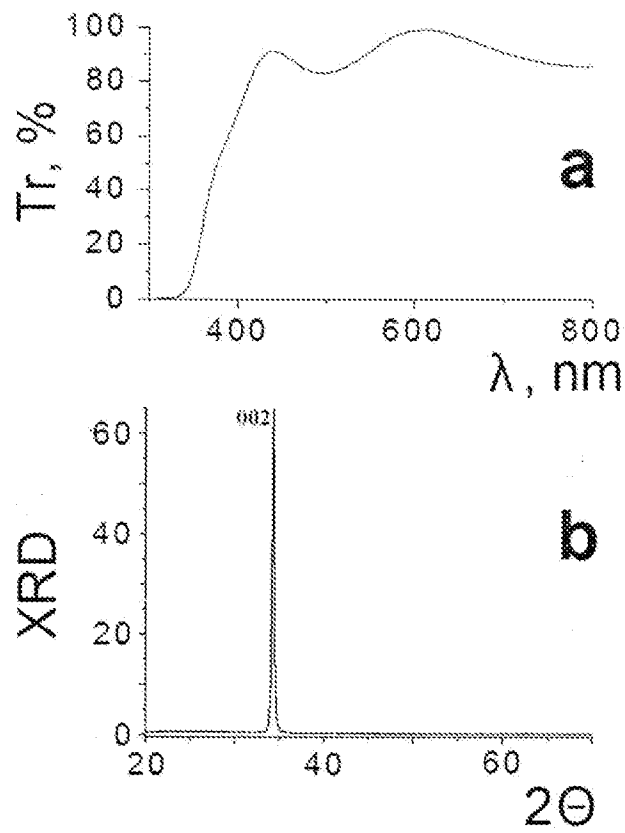


Fig. 5

RAPORT DE DOCUMENTARE

I. Datele de identificare a cererii		
(21) Nr. depozit: a 2020 0024		
(22) Data depozit: 2020.03.27		
(71) Solicitant: UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD		
(54) Titlu: Procedeu de obținere a ceramicii și filmelor subțiri de ZnO:Ga:Cl la temperaturi scăzute		
II. Clasificarea obiectului invenției:		
(51) Int.Cl: C01G 9/00 (2006.01) C04B 35/453 (2006.01) C01G 15/00 (2006.01) C04B 35/65 (2006.01) C04B 35/00 (2006.01) C30B 13/18 (2006.01)		
III. Colecții și Baze de date de brevete cercetate (denumirea, termeni caracteristici, ecuații de căutare reprezentative)		
MD - Intern « Documentare Invenții » (inclusiv cereri nepublicate; trunchiere automată stânga/dreapta): Int.Cl: C01G 9/00 (2006.01); C01G 15/00 (2006.01); C01B 35/00 (2006.01); C01B 35/01 (2006.01); C01B 35/453 (2006.01); C01B 35/50 (2006.01); C01B 35/65 (2006.01); C30B 13/16 (2006.01); C30B 13/18 (2006.01); procedeu; electrod- sculă; zinc; zno; țintă; prelucrare electrochimică a metalelor; "Worldwide" (Espacenet): Int.Cl: C01G 9/00 (2006.01); C01B 35/01 (2006.01); C01B 35/65 (2006.01); C01G 15/00 (2006.01); C01B 35/453 (2006.01); C30B 13/16 (2006.01); C01B 35/00 (2006.01); C01B 35/50 (2006.01); C30B 13/18 (2006.01); method; electrode tool; method producing ceramics ZnO; zno; target; ceramic; transport hcl; hydrogen EA, CIS (Eapatis) SU: Int.Cl: C01G 9/00 (2006.01); C01B 35/01 (2006.01); C01B 35/65 (2006.01); C01G 15/00 (2006.01); C01B 35/453 (2006.01); C30B 13/16 (2006.01); C01B 35/00 (2006.01); C01B 35/50 (2006.01); C30B 13/18 (2006.01); метод; электрод инструмент; химичек*; hcl мишен*; транспорт*; реакц*; керамик*; хлороводор*		
IV. Baze de date și colecții de literatură nonbrevet cercetate		
www.google.com https://ro.wikipedia.org		
V. Documente considerate a fi relevante		
Categoria*	Date de identificare ale documentelor citate si, unde este cazul, indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A, D	Jia Liua, Weijia Zhanan, Dengyuan Songb, Qiang Maa, Lei Zhangb, Hui Zhange, Xiaobo Maa, Haiyang Songa, Comparative study of the sintering process and thin film sputtering of AZO, GZO and AGZO ceramics targets, Ceramics International, 2014, Vol. 40, p 12905 - 12915	1, 2
A, D, C	Абдуев А.Х., Асваров А.Ш., Ахмедов А.К., Зобов М.Е., Крамынин С.П., Изменение структуры и стехиометрии керамики оксида цинка в процессе спекания в открытой атмосфере, Мисьма в ЖТФ, 2015, Vol. 41, p. 42 - 49	1, 2

A, D, C	Абдуев А.Х., Ахмедов А.К., Асваров А.Ш., А.А. Абдулаев, Сульянов С.Н., Влияние температуры роста на свойства прозрачных проводящих пленок ZnO, легированных галием, Физика и техника полупроводников, 2010, Vol. 44, p. 34 - 38	1, 2
A	US 3403085 A 1968.09.24	1, 2
A	SU 722718 A1 1980.03.25	1, 2
A	MD 68 Y 2009.08.31	1, 2
A	EA 200000002 A1 2000.08.28	1, 2
A	RO 128030 A2 2012.12.28	1, 2
A	MD 3364 B1 2007.07.31	1, 2
A	RU 2004112740 A 2005.10.27	1, 2
A	JP 2005001928 A 2005.01.06	1, 2
A	MD 208 Y 2010.05.31	1, 2
A	GB 952630 A 1964.03.18	1, 2
A	EA 200200055 A1 2002.06.27	1, 2
A	MD 20050351 A 2007.05.31	1, 2
A	BG 111197 A 2013.10.31	1, 2
A	MD 4005 B1 2010.01.29	1, 2
A	MD 4455 B1 2016.12.01	1, 2
A	MD4500 B1 2017.07.31	1, 2
A	MD 4517 B1 2017.09.30	1, 2
A	WO 2008023482 A1 2008.02.28	1, 2
A	RU241252 C2 2013.08.27	1, 2
A	BY 13106 C1 2010.04.30	1, 2
A	SU 992485 A1 1983.01.30	1, 2
A	MD 20180065 A2 2020.02.29	1, 2
A	RU 2280015 C2 2006.07.20	1, 2
A	EP 2053028 A1 2009.04.29	1

*** categoriile speciale ale documentelor citate:**

A – document care definește stadiul anterior general	T – document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidența principiul sau teoria pe care se bazează invenția
X – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă când documentul este luat în considerație de unul singur	E – document anterior dar publicat la data depozit național reglementar sau după aceasta dată
Y – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe documente de aceeași categorie	D – document menționat în descrierea cererii de brevet
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expoziție sau la orice alte mijloace de divulgare	C – document considerat ca cea mai apropiată soluție
	& – document, care face parte din aceeași familie de brevete
P - document publicat înainte de data de depozit, dar după data priorității invocate	L – document citat cu alte scopuri

Data finalizării documentării, 2023.03.01

Examinator , SPATARU Leonid